

2SA934 (3CG934)

硅 PNP 半导体三极管/SILICON PNP TRANSISTOR

用途：用于 1~2W 输出电路及驱动电路。

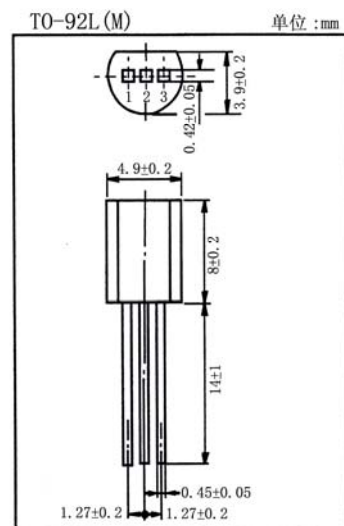
Purpose: 1~2W output circuits.

特点：集电极耗散功率大，饱和压降低，与 2SC2060 (3DG2060) 互补。

Features: High collector dissipation, low saturation voltage, complementary pair with 2SC2060 (3DG2060).

极限参数/Absolute maximum ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	-40	V
V_{CE0}	-32	V
V_{EB0}	-5.0	V
I_C	-1.0	A
I_{CP}	-2.0	A
P_C	750	mW
T_j	150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$



引脚： 1. E 2. C 3. B

电性能参数/Electrical characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CB0}	$I_C=-50\ \mu\text{A}$ $I_E=0$	-40			V
V_{CE0}	$I_C=-1.0\text{mA}$ $I_B=0$	-32			V
V_{EB0}	$I_E=-50\ \mu\text{A}$ $I_C=0$	-5.0			V
I_{CB0}	$V_{CB}=-20\text{V}$ $I_E=0$			-0.5	μA
I_{EB0}	$V_{EB}=-4.0\text{V}$ $I_C=0$			-0.5	μA
h_{FE}	$V_{CE}=-3.0\text{V}$ $I_C=-100\text{mA}$	82		390	
$V_{CE(sat)}$	$I_C=-500\text{mA}$ $I_B=-50\text{mA}$		-0.2	-0.5	V
f_T	$V_{CE}=-5.0\text{V}$ $I_C=-50\text{mA}$	50	150		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=-10\text{V}$ $I_E=0$ $f=1.0\text{MHz}$		20	30	pF

h_{FE} 分档/ h_{FE} classifications: P:82~180 Q:120~270 R:180~390